



汕头华汕电子器件有限公司

NPN SILICON TRANSISTOR

HS13002

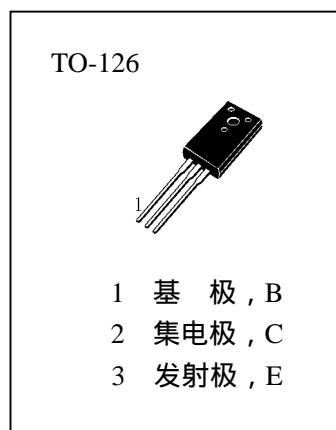
主要用途

高压快速开关

极限值 ($T_a=25$)

T_{stg} ——贮存温度.....	-55~150
T_j ——结温.....	150
P_C ——集电极耗散功率($T_c=25$).....	10W
V_{CBO} ——集电极—基极电压.....	600V
V_{CEO} ——集电极—发射极电压.....	400V
V_{EBO} ——发射极—基极电压.....	9V
I_C ——集电极电流 (DC)	0.25A

外形图及引脚排列



电参数 ($T_a=25$)

参数符号	符号说明	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
BV_{CEO}	集电极—发射极击穿电压	400			V	$I_C=10mA, I_B=0$
BV_{CBO}	集电极—基极击穿电压	600			V	$I_C=1mA, I_E=0$
BV_{EBO}	发射极—基极击穿电压	9			V	$I_E=1mA, I_C=0$
I_{CBO}	集电极—基极截止电流			100	μA	$V_{CB}=500V, I_E=0$
I_{EBO}	发射极—基极截止电流			100	μA	$V_{EB}=9V, I_C=0$
HFE	直流电流增益	10		40		$V_{CE}=10V, I_C=20mA$
$V_{CE(sat)}$	集电极—发射极饱和压降			0.6	V	$I_C=100mA, I_B=20mA$
$V_{BE(sat)}$	基极—发射极饱和压降			1.2	V	$I_C=100mA, I_B=20mA$
f_T	特征频率	8			MHz	$V_{CE}=10V, I_C=20mA$

分档及其标志

H1	H2	H3	H4	H5
10-16	14-21	19-26	24-31	29-40